

**GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER**

**VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 16 Amperes**

**FEATURES**

- \* Low power loss, high efficiency
- \* Low forward voltage drop
- \* Low thermal resistance
- \* High current capability
- \* High surge capability
- \* High reliability

**MECHANICAL DATA**

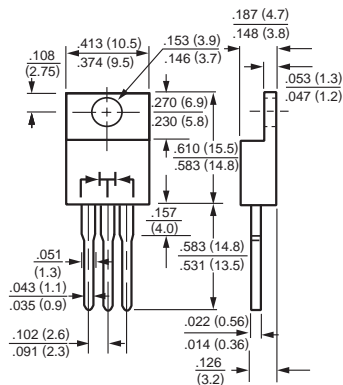
- \* Case: TO-220 molded plastic
- \* Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O
- \* Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- \* Mounting position: Any
- \* Weight: 2.24 grams
- \* Polarity: As marked

**MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.  
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.  
 For capacitive load, derate current by 20%.



**TO-220**



**MAXIMUM RATINGS** (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	RL16 01C	RL16 02C	RL16 03C	RL16 04C	RL16 05C	RL16 06C	RL16 07C	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current TC = 100°C (Note 1)	IO	16.0							Amps
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	200							Amps
Typical Thermal Resistance	RθJC	3.0							°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 2)	CJ	40							pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-65 to + 150							°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RL16 01C	RL16 02C	RL16 03C	RL16 04C	RL16 05C	RL16 06C	RL16 07C	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 8.0A DC	VF	1.1							Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@Tc = 25°C	10							uAmps
	@Tc = 100°C	100							

NOTES : 1. Case Temperature Measured at Metal Tab.  
 2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.  
 3. Suffix " A " = Common Anode.

# RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( RL1601C THRU RL1607C )

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

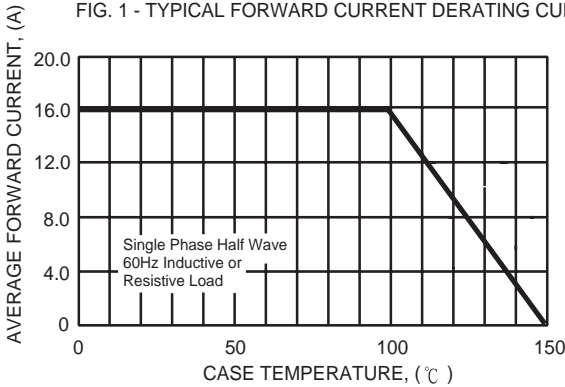


FIG. 2 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

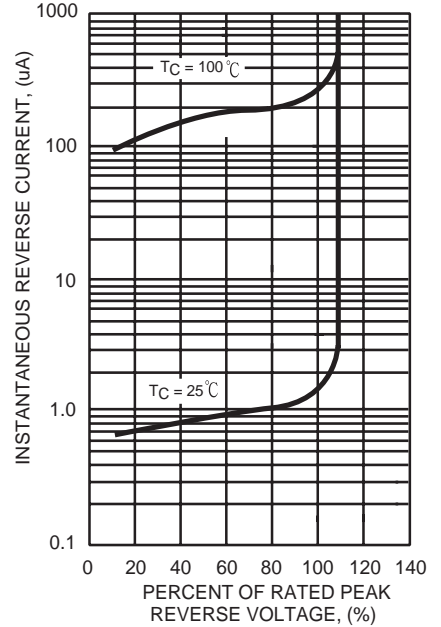


FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

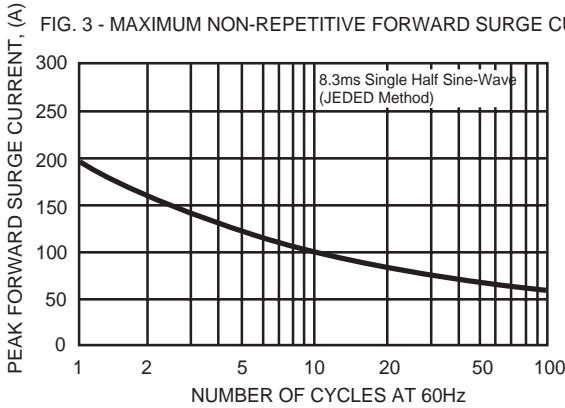


FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

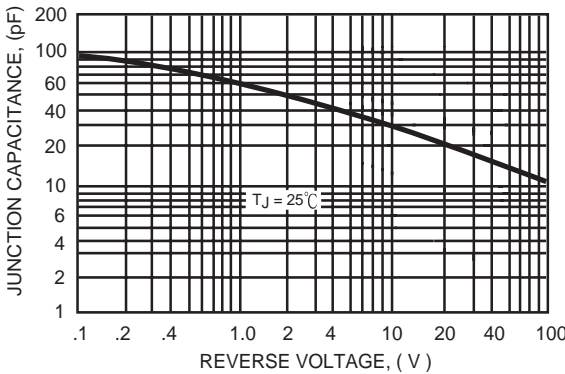
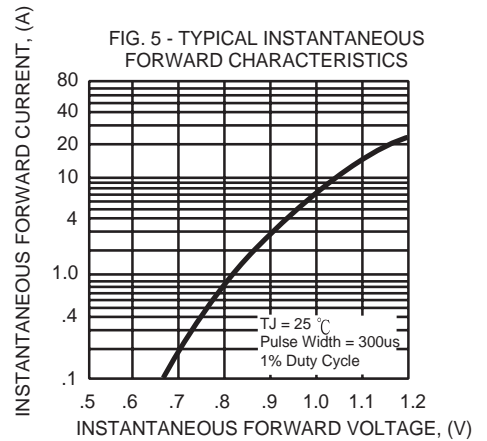


FIG. 5 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.